INJECTION ENERGY RECOVERY OF J-PARC RCS

Naoki Hayashi^{* A)}, Hideaki Hotchi^{A)}, Junichiro Kamiya^{A)}, Saha Pranab^{A)}, Tomohiro Takayanagi^{A)},

Kazami Yamamoto^{A)}, Masanobu Yamamoto^{A)}, Yoshio Yamazaki^{A)},

^{A)}Accelerator Division, J-PARC Center (JAEA)

2-4 Shirakata-Shirane, Tokai, Naka-gun, IBARAKI, 351-1195

Abstract

The J-PARC RCS is a high beam power Rapid-Cycling Synchrotron (RCS). The original designed injection energy is 400MeV, although presently it is 181MeV, and its beam power is limited to 0.6MW. Works to recover the Linac energy are ongoing and injection magnets power supplies upgrade are required in the RCS. In order to achieve 1MW designed beam power, new instrumentation is also planned simultaneously. Activities related injection energy recovery in the J-PARC RCS is presented.

J-PARC RCS の入射エネルギー回復

1. はじめに

J-PARC RCS の初期設計時の入射エネルギーは、 400MeV である^[1]が、現在は、181MeV で入射を行っ ている^[2]。ビームパワー 1MW 達成のための条件とし て、入射時の空間電荷効果を抑制するため、入射エネル ギーをデザイン当初の 400MeV に回復させることが必 須である。現状、181MeV, beam power 0.3MW 相当(粒 子数 $N = 2.5 \times 10^{13} ppp$), $\epsilon = 216\pi mm \cdot mrad$, $B_f = 0.4$ において、tune shift $\Delta \nu \sim 0.15$ である。エネルギーが 単純に、300, 400MeV と上がると、tune shift は、単純 に $\Delta \nu \propto \beta^{-2} \gamma^{-3}$ なので、1/2, 1/3 となる。400MeV に なれば、1MW 相当の粒子数 $N = 8.3 \times 10^{13} ppp$ でも、 $\Delta \nu \sim 0.15$ だが、181MeV のままでは、 $\Delta \nu \sim 0.5$ 近くに なり、大きなビームロス要因になる。このため、181MeV のエネルギーでは、0.6MW をビームパワーの上限、と 設定している。

400MeVにした場合、その他の影響について考えてみ ると、入射エネルギーに直接関係しない、誤差磁場の影響は、小さくなる。また主電磁石の制御は、DCに対し 25Hz で変動している分を重畳しているので、DC成分 が増えるだけ、実効電流値は増えるが、磁場の tracking 自体は、楽な方向に向かうはずである。仮にビームロス による散乱が起きた時、その角度分布は、約1/3になる ので局所的な残留線量は、減る傾向と考えられる。た だ、各粒子のエネルギーが高くなっているので、この点 で状況が改善すると断定はできない。

2. 入射機器増強

RCS では、入射時の空間電荷効果の緩和の為、 216πmm・mrad の位相空間領域にに均等にビームを 入射する painting を行っている^[3,4]。入射の主要な機 器は、周回ビームを単純に水平移動させる水平シフト バンプ、フォイル位置での周回ビームを時間的に変え て、入射ビームが emittance の楕円の特定の一部を占め るように制御してやる水平ペイントバンプ、入射ビーム の位置は変えないが、パルス毎に傾きのみ変える、リ ニアックから RCS へのビーム移送ライン (L3BT) 上最 終段のの可変偏向電磁石がある。同様に、vertical 方向 の painting を行う、垂直ペイントバンプも L3BT 上にあ る。rigidity $B\rho$ は、181MeV で、2.0356、400MeV で、 3.183 なので、現行では電流値が不足する電源、主にバ ンプ電磁石等、は増強する。DC のセプタム電磁石は、 既に 400MeV のデザイン要求通りに作られているので、 増強の必要はない。

2.1 シフトバンプ電磁石電源

水平シフトバンプ、及び水平ペイントバンプ電源の増 強計画の概要については、既に報告している^[5]。

現行の IGBT チョッパ方式は、複数の IGBT(単体の素 周波数 6kHz) を多重化 (8 重化) したもので、電源全体 としては、基本、48kHz の ripple があることが分かって おり、その高調波も電磁石にあるサーチコイルで観測さ れている。

ビームにあらわれる影響として、入射時に、 $\Delta \nu = 0.2 \sim \frac{100 k Hz}{469 k Hz}$ の、side band が観測されていた。さらに、調査するために、加速器の study 時に特殊な運転条件、「加速しない直流モードかつビームを出射せず、入射後40ms後に再度バンプ電磁石を励磁し」、バンプ領域の外の BPM で turn-by-turn でビーム位置の振動を調べた。 軌道の振動は大きなところで、10mm、さらに周波数解析するとやはり、100kHzの成分があった。

電源から ripple が出ていることが原因の一つだが、負荷の電磁石側側も、この 100kHz 付近のノイズを強める 特性を持っている、と考えられる。最近、4 台直列の電 磁石を、1 から 4 について、個別にインピーダンスを測 定したところ、共鳴が、100kHz 付近にあるが、個々に 周波数が微妙にずれていることが分かった。特に、ビー ムを外側に蹴る 1、4 番目とビームを内側に蹴る 2,3 番 目で周波数が異なっていた。詳細な計算が必要だが、こ の電磁石側の影響もあり、 $\Delta \nu \sim 0.2$ があると思われる。

また、このノイズは、パルス毎の再現性がない。J-PARC の timing システムと IGBT のキャリアーとが非 同期の為、生じていると思われるので、偏向電磁石で実 施したような同期化をする作業を進める予定でいる^[6] 。ノイズを消すことはできないが、平均化処理等により 種々のビーム調整の確度が上がると期待している。

400MeV 入射時には、switching ripple の少ない電源 方式 (コンデンサバンク方式) に変える方針である。全 体で、定格電流 32kA, 最大電圧 13kV の電源を構成す

^{*} naoki.hayashi@j-parc.jp

るため、16並列の電源とし、さらにその一並列分の電源も複数のユニットで構成するようにしている。また、 switching 回数が少なくても、その転流時に発生するノ イズ、及びその影響について試験、検討を実施している ところである。

2.2 ペイント電磁石電源

ペイントバンプ電磁石電源も、現行シフトバンプ電 源と同様 IGBT チョッパ方式の電源である。ただ、シフ トバンプ電源に比べ要求仕様電圧が低いため、より高速 な IGBT 素子を用いている¹。こちらも、シフトバンプ の場合と同様、実際にビームを使った試験をした。水平 ペイントバンプは、4 台の電磁石を独立な電源で給電し ている為、パンプ領域の外で、若干の COD がでている ものの、シフトバンプの場合に見られたような振動は見 られなかった。

また、シフトバンプと異なり、多様な任意波形パターンが必須であるため、それに適した現行の IGBT チョッパ方式で、ペイントバンプ電磁石は増強する。計画としては、まず1台分を新規製作する。残り3台は、現行電源にチョッパ盤を付加した形で増強をする。

一般に、定格の大きい電源で、低電流で運転する際に 精度が問題になる。特に、400MeVになるまで、或いは、 小さなペイント領域にする際は、それが懸念される。最 近、小さなペイント領域を実現するため、低電流の運転 中に、一部の電源の制御が不安定になることがあった。 この電源の制御は、マイナー電圧制御(m-AVR)付き定 電流制御(ACR)^[7]を使っているが、調査の結果、他電 源起源のノイズが出力電圧を検知しフィードバックする 2本の同軸ケーブルに混入したことが要因であることが 分かった。幾らかの試行錯誤と100kHz程度までは、ツ イストペア線の方がノイズに強いということから、対策 として、3芯ツイストペア線に置き換えることで解決し た。これは、新しい電源、改造時に対応してゆく。

2.3 可変偏向電磁石システム

可変偏向電磁石は、2つの役割、

- MR/MLFと beam size (emittance)を切替えて運転 する
- ペイントバンプを使わない center 入射をする

がある [8]。

「center入射」は、「painting入射」と対比するモード で、入射ビームを周回ビームの全て同じ位相空間上に入 れることである。通常の運転には、用いないが、beam studyや、調整運転の初期にシフトバンプのみを使った 入射調整の際に必要となる。181MeV入射の際は、入 射セプタム電磁石に設計時より多い電流を流すことで kick量を稼ぎ、使用しなくてもよかったが、400MeV入 射になると、入射セプタムの定格励磁量では足りなくな り、DCモードで構わないので、可変偏向電磁石に、数 1000Aを流す必要が出てくる。

また、運転当初は、MR/MLFと beam size を切替え て運転する要求は、強くなかった。しかし、徐々にユー ザー側でも、中性子ターゲット向けには、ターゲット の衝撃を減らすためなるべく広いビームを、MR向けには、特に、MRまでのビームトランスポートラインのphysical aperture の制約からなるべく細いビームを、という要求が切実になってきている。これら、ペインティング領域の切替の為のパターン運転も必要である。磁石は、L3BT上の入射セプタム1と2の上流に2台設置する。電源は、3000ADCと400Aパルス用のモードを分けた電源を用意する。

3. ダンプセプタムコリメータ

現在、RCSのビームロスの多い場所は、コリメータ部 を除き、荷電変換フォイル下流部である。これは、multiturn injectionのスキームを採用したことに由来するもの で、入射が続く間、既に周回しているビームが常に、フォ イルに当り続けることによるものである。フォイルを小 さくすることと、painting 操作により、空間的にもビー ムの存在する領域を広げ、なるべくフォイルに当る粒子 数を減らすなどの対処をしているが、限界がある。フォ イルを小さくしすぎると、Linacからのビームのすその 部分(ハロー部分)が荷電変換されず、H0ダンプへビー ムが捨てられてしまう。

運転開始前に、入射点のフォイルからコリメータ領域 までの間で、合計 10W 程度のビームロスは、予想され ていた^[9]。ただ、十分な統計精度がなく、損失が局所 化されることまでは分からなかった。これに対し、フォ イル下流部からのロスを現在の第1コリメータ手前で 回収するためにダンプラインとの分岐部にダンプセプ タムコリメータを設置する^[10]。

4. 漏れ磁場対策

初期の beam commissioning の時に、RCS 出射部付近 の漏れ磁場、出射セプタムによるものと、出射後のビー ム輸送ラインにある偏向電磁石によるもの、それぞれ、 22,29 Gm の漏れ磁場の影響を測定した^[11]。2009 年に 磁場シールドを追加したが、作業性を優先し、簡易的な 方式を採用したため、ダクトの接続部や真空ポンプの ある枝管部は、シールドされないまま残った。その後、 ビームを使った測定によれば、30~40% を減らす効果 しか認められなかった。このため、漏れ磁場をさらに 1/10 に減らすよう、ダクト自体を磁性体材料に変更し 再製作し、取り替えることにしている。

5. 補正四極電磁石システム

入射時にシフトバンプ電磁石が励磁されている間、 edge focus 効果により、四極成分が発生しこれが、特に vertical 方向の β 関数を非常に歪ませている。これによ るビームロスの効果も無視することはできず、これを補 正する系として、補正四極電磁石システムを検討してい る。元々、この加速器には、非常に限られたスペースし かないが、3 回対称の各直線部の両端には、わずかなが ら将来の補正用機器を置くスペースを確保していたの で、ここに全部で6台の磁石を設置する。

6. キッカー電磁石のインピーダンス

RCS の出射キッカー電磁石は、反射型のキッカーであり、電源側から見たトンネル内での磁石は短絡され、

¹素周波数は、50kHz、多重化により電源全体としてとして 600kHz。

かつ通常 OFF 時は、ビーム側から見ると電源側は開放 端としてみえる。このため、インピーダンスが大きく ビーム不安定性を引き起こすことが指摘されており、粒 子数増強に伴う最大の問題になりうる^[12]。キッカーを トンネル内でマッチングさせる方式に改造するのは、大 がかりであり、下記に述べる方法、もしくは、横方向ダ ンパーを導入することが検討されている。

実際に、ビームパワー 300kW 相当で、六極電磁石の パターン化で可能になったクロマティシティ制御をする と、水平方向のビーム不安定性が誘起されることが確認 され、ビームが誘起する電圧 (~140V) も観察した。

キッカー電源は、ON 状態の時、電磁石側からの戻っ てくる反射波を高耐圧ダイオードと抵抗で構成される エンドクリッパーで吸収する。概念としては、スイッチ であるサイラトロンより磁石側にエンドクリッパーと同 機能のものを置き、ビームが誘導する電磁石からの波は 吸収し、キッカーへ給電する進行波は、通す、という役 割を持たせる。ただ、逆電圧に対し 50kV の高耐圧なが ら、高々300V 程度の順方向電圧でもダイオードとして は機能させるデバイスは大きな課題である。

7. ビームモニタ他

他にもビームパワー増強に伴い、ビームをより精度 よく観察し、ビームロス低減の為に、リング内のビーム のプロファイルである、IPM (Ionization Profile Monitor) の dispersion free 領域への追加、及びその電極構造の改 良、ビームハローや電子雲を測定するためのビームモニ タの追加、ビームロスモニタの増強等を計画している。

さらに、Linac からの H⁻ を荷電変換するフォイルは、 最初の第1フォイル以外、第2、3のフォイルは、目視 監視できていない。今後の長期運転、大電流化で、それ らの機能追加も必要となってくる。

8. スケジュール

2011 年 3 月の東日本大震災の影響で、J-PARC 施設 全体も大きな影響を受けた。2011 年度の運転は、施設 の復旧工事の為停止しており、年度末に 2 サイクルの運 転を予定している^[13]。

震災前は、来年度に長期5カ月の停止中に、400MeV upgradeの移行、さらに2013年度にイオン源、RFQの 50mA化を計画していた。震災後の計画では、今年度の 長期停止をユーザに対し補う形で、来年度は、通常の夏 のメインテナンス、3か月のみ、を見込んでいる。その ため、入射エネルギーの400MeV回復、及び大電流化 は、共に2013年度になる見通しである。

現在、流動的要素がまだ含まれているが、RCS の 400MeV への移行は、順次、準備ができたものからイ ンストールし、試験調整はしてゆく。ただ、最重要かつ 最大のシフトバンプ電源については、長期の据付調整期 間を要することから、最終年度の見込みである。

9. まとめ

J-PARC では、Linac のエネルギー回復に伴い、RCS の入射機器機器増強が計画され、徐々に実行に移されて いる。また、2007年の RCS beam commissioning 開始後 からの経験も踏まえ、最終的な design 値であるビーム パワー 1MW に向けた対策も検討している。これらの対 策、増強は、今年の大震災の影響を踏まえ、2013 年度 完了を目指し推進している。

参考文献

- Y. Yamazaki eds., Accelerator Technical Design Report for High-Intensity Proton Accelerator Facility Project, J-PARC, KEK-Report 2002-13; JAERI-Tech 2003-044.
- [2] H. Hotchi, et al., "Beam commissioning of the 3-GeV rapid cycling synchrotron of the Japan Proton Accelerator Research Complex" *Phys. Rev. ST Accel. Beams* 12, 040402 (2009)
- [3] P.K. Saha, et al., "Direct observation of the phase space footprint of a painting injection in the Rapid Cycling Synchrotron at the Japan Proton Accelerator Research Complex" *Phys. Rev. ST Accel. Beams* 12, 040403 (2009)
- [4] 原田寛之、「ビームの入射・取り出し1負水素イオンビーム入射」OHO'10 (2010)
- [5] T. Takayanagi, et al., "バンプシステムの性能向上計画", Proc. of the 7th Annual Meeting of Particle Accelerator Society of Japan, p.584-586., Himeji, Japan (2010)
- [6] Y. Watanabe, et al., "Suppression Scheme of COD Variation Caused by Switching Ripple in J-PARC 3GeV Dipole Magnet Power Supply" *Proceedings of IPAC'10*, p.3242-3244., Kyoto, Japan (2010)
- [7] 高柳智弘、他「高精度大電流パルス励磁電源の開発」電 気学会論文誌 D 127 p.813-p.821 (2007)
- [8] T. Takayanagi, et al., "Design of the Pulse Bending Magnet for Switching the Painting Area between the MLF and MR in J-PARC 3-GeV RCS" *Proceedings of IPAC'10*, p.3293-3295., Kyoto, Japan (2010)
- [9] P.K. Saha, et al., "Realistic Beam Loss Estimation from the Nuclear Scattering at the RCS Charge-exchange foil" *Proceedings of EPAC 2006*, p.333-335., Edinburgh, Scotland (2006)
- [10]加藤新一、他「J-PARC 3GeV RCS入射部コリメータの 最適化」このプロシーディングス参照。MOPS019. 山本風海、他「J-PARC 3GeV RCS 入射部コリメータによ るロス低減」このプロシーディングス参照。MOPS025.
- [11] M. Yoshimoto, et al., "Leakage Field of Septum Magnets of 3GeV RCS at J-PARC" *Proceedings of EPAC08*, p.3626-3628., Genova, Italy (2008)
- [12] Y.HM. Chin, et al., "Impedance and Beam Instability issues at J-PARC Rings" *Proceedings of HB2C08*, p.40-44., Nashville, Tennesee, USA (2008)
- [13] 長谷川和男、「J-PARC 加速器の現状」このプロシーディ ングス参照。MOPS003.